DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2004 EPO. All rts. reserv.

18281557

Basic Patent (No, Kind, Date): US 20020172813 AA 20021121 <No. of Patents: 002>

Transfer film and process for producing organic electroluminescent device

using the same (English)

Patent Assignee: OGURA TAKASHI (JP); YAMANA SHINJI (JP); AKAI TOMONORI (JP)

Author (Inventor): OGURA TAKASHI (JP); YAMANA SHINJI (JP); AKAI TOMONORI

(JP)

National Class: *428212000; 428690000; 428917000; 156067000; 427066000;

430200000

IPC: *B32B-007/02; H05B-033/10 Language of Document: English

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 2002343564 A2 20021129 JP 2001148587 A 20010518

US 20020172813 AA 20021121 US 136518 A 20020502 (BASIC)

Priority Data (No,Kind,Date):

JP 2001148587 A 20010518

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2004 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

Image available 07475046

TRANSFER **FILM** AND MANUFACTURING METHOD OF **ORGANIC**

·ELECTROLUMINESCENCE

ELEMENT USING THE SAME

PUB. NO.:

2002-343564 [JP 2002343564 A]

PUBLISHED:

November 29, 2002 (20021129)

INVENTOR(s): OGURA TAKASHI

YAMANA SHINJI

AKAI TOMONORI

APPLICANT(s): SHARP CORP

APPL. NO.:

2001-148587 [JP 2001148587]

FILED:

May 18, 2001 (20010518)

INTL CLASS: H05B-033/10; B44C-001/17; H05B-033/14; H05B-033/28

ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a transfer film that has solved the problem of the transfer film and the manufacturing method of an organic electroluminescence element using the same and can make transfer in good condition, and a manufacturing method of the organic electroluminescence element using the same.

SOLUTION: The transfer film 2 comprises a transfer auxiliary layer 5 that is formed between the base film 2a and the transfer layer 1 in contact with at least the transfer layer 1 and has a melting point lower than the transfer layer 1. At least a part of the transfer auxiliary layer 5 and the transfer layer 1 is transferred on the other substrate 4 by heating A.

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-343564

(P2002-343564A) (43)公開日 平成14年11月29日(2002.11.29)

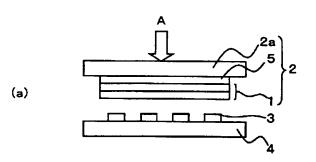
(51) Int. Cl. 7	識別記号	FΙ	テーマコード (参考	
H05B 33/10		H05B 33/10	3B005	
B44C 1/17		B44C 1/17	7 D 3K007	
H05B 33/14		H05B 33/14	1 A	
33/28		33/28		
		審査請求	: 未請求 請求項の数12 OL (全9頁)	
(21)出願番号	特願2001-148587(P2001-148587)	(71)出願人	000005049	
			シャープ株式会社	
(22) 出願日	平成13年5月18日(2001.5.18)		大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号	
		(72)発明者	小倉 隆	
			大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内	
		(72)発明者	山名 真司	
			大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ	
			ャープ株式会社内	
	·	(74)代理人	100102277	
			弁理士 佐々木 晴康 (外2名)	
			最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】転写用フィルムおよびそれを用いた有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法

(57)【要約】

た有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法に関する課題を解決し、転写を良好に行うことが可能な転写用フィルムの提供と、それを用いた有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法を提供することを目的とする。【解決手段】 ベースフィルム2aと転写層1との間に少なくとも転写層1に接して形成され転写層1よりも融点が低い転写補助層5を有し、転写補助層5及び転写層1の少なくとも一部が加熱Aにより他の基板4上に転写形成されることを特徴とする転写用フィルム2。

【課題】 本発明は、転写用フィルムおよびそれを用い





【特許請求の範囲】

【請求項1】 ベースフィルム上に転写層を有する転写 用フィルムにおいて、前記ベースフィルムと前記転写層 との間に少なくとも前記転写層に接して形成され前記転 写層よりも融点が低い転写補助層を有し、前記転写補助 層及び前記転写層の少なくとも一部が加熱により他の基 板上に転写形成されることを特徴とする転写用フィル

1

【請求項2】 ペースフィルム上に転写層を有する転写 との間に少なくとも前記転写層に接して形成され前記転 写層よりもガラス転移温度が低い転写補助層を有し、前 記転写補助層及び前記転写層の少なくとも一部が加熱に より他の基板上に転写形成されることを特徴とする転写 用フィルム。

【請求項3】 前記転写層には、少なくとも有機発光材 料を含有するエレクトロルミネッセンス層が含まれてい ることを特徴とする請求項1または2に記載の転写用フ

いることを特徴とする請求項1乃至3のいずれかひとつ に記載の転写用フィルム。

【請求項5】 前記金属電極層は、光を透過する金属薄 膜層であることを特徴とする請求項4に記載の転写用フ ィルム。

【請求項6】 前記転写層には、透明導電膜層が含まれ ていることを特徴とする請求項1乃至3のいずれかひと つに記載の転写用フィルム。

【請求項7】 前記転写補助層および前記転写層は、不 活性ガス中または真空中で連続して形成されることを特 30 徴とする請求項1乃至6に記載の転写用フィルム。

【請求項8】 転写法で有機エレクトロルミネッセンス 素子を製造するにあたり、請求項1乃至7のいずれかひ とつに記載の転写用フィルムを用いることを特徴とする 有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。

【請求項9】 前記転写法は、前記転写補助層への加熱 を部分的に行うことによりパターニングされた発光部を 形成することを特徴とする請求項8に記載の有機エレク トロルミネッセンス素子の製造方法。

【請求項10】 前記パターニングされた発光部は、複 40 数の発光色を有することを特徴とする請求項9に記載の 有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。

【請求項11】 光一熱変換層を有する転写用フィルム を用い、光照射により前記転写補助層への加熱を部分的 に行うことを特徴とする請求項9または10に記載の有 機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。

【請求項12】 前記光照射に用いる光源が、レーザ光 であることを特徴とする請求項11に記載の有機エレク トロルミネッセンス素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、転写用フィルムお よびそれを用いた有機エレクトロルミネッセンス素子の 製造方法に関する。

2

[0002]

【従来の技術】近年、ブラウン管(CRT)よりも薄 型、低消費電力、軽量の表示装置としてフラットパネル ディスプレイへのニーズが高まっている。

【0003】この、フラットパネルディスプレイとして 用フィルムにおいて、前記ベースフィルムと前記転写層 10 は、非発光型の液晶ディスプレイ(LCD),自発光型 のプラズマディスプレイ (PDP), エレクトロルミネ ッセンス(EL)ディスプレイ等が知られている。

> 【0004】その中でもELディスプレイは、その発光 機構およびその構成材料の違いから、無機ELディスプ レイと有機ELディスプレイの2つに分けられる。特 に、有機ELディスプレイは、自発光であること、低消 費電力化が図れること、発光色が多様であること等の特 徴を有するため、非常に注目を集めている。

【0005】有機ELディスプレイに用いられる有機エ 【請求項4】 前記転写層には、金属電極層が含まれて 20 レクトロルミネッセンス素子は少なくとも一方が透光性 である一対の電極間に有機物による発光層と必要に応じ てホール注入輸送層、電子注入輸送層等を挟んだ構造を 有し、低電圧駆動、高輝度の発光が可能であることから 盛んに研究が行われている。

> 【0006】上記のような、有機ELディスプレイに用 いられる有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法 において、特にマトリクスディスプレイやカラーディス プレイ等を製造する場合には、発光層や陰極を特定のパ ターンに形成することが必要となる。しかしながら、有 機エレクトロルミネッセンス素子を構成する有機材料は 有機溶剤や水、酸素等により侵食や特性の低下等のダメ ージを受けやすいため、一旦有機材料を層形成した後は 一般的なフォトリソグラフィー法によりパターンを形成 することが困難である。

【0007】このため、発光色の異なる発光層や陰極を パターン形成する方法としては、マスク蒸着によりパタ ーン形成するマスク蒸着法や、基板上にあらかじめ隔壁 を形成しておいて蒸着によりパターン形成する方法、イ ンクジェット方式を用いてパターン形成するインクジェ ット法等が、例えば特開平11-135257号公報. 特開平8-315981号公報,特開平8-22727 6号公報,特開平5-275172号公報等に開示され ている。しかしながら蒸着によりパターンを形成する方 法では、パターンの髙精細化が難しかったり、蒸着時の 回り込みを考慮したマスクの位置合わせが困難である、 また工程が複雑になる等の理由により、生産上必ずしも 十分なものとは言えなかった。更に、マスク蒸着法では 大型基板への蒸着が困難であるという問題があり、イン クジェット法でも大型基板を用いると時間がかかるため

50 生産性が落ちる等の問題があった。

【0008】一方、上記パターン形成に代わる方法とし て、例えば特開平9-167684号公報,特開平10 -208881号公報,特開平11-237504号公 報, 特開平11-260549号公報, 特開2000-12216号公報, 特開2000-77182号公報に 開示されているようなレーザ照射による光や局所化され た加熱要素による熱の供給を利用した転写法を用いたパ ターン形成方法が知られている。これらの転写法を用い たパターン形成方法は、大型基板を用いる事が可能であ り、作製時間を大幅に短縮することが可能なパターン化 10 方法として注目されている。

【0009】従来のレーザ照射による転写法を用いたパ ターン形成方法を説明した断面図を図4に示す。

【0010】図4は、従来の転写用フィルムおよびそれ を用いた有機エレクトロルミネッセンス素子の製造工程 の一部を表しており、フィルム41上に光-熱変換層4 2および熱伝播層43を形成し、次に陰極層44を形成 し、次に発光層45bを重ねて形成し、次に正孔注入性 接着層45cを重ねて形成した後、フィルム41の成膜 面側をストライプパターニングしたITO陽極48付き 20 基板47上に貼り付け、その後フィルム41の裏面側か ら13WのYAGレーザー51を陰極形状を形成するよ うに選択的に照射することにより多重に形成した層46 を基板47上に転写する。その後、フィルム41を取り 除き、多重に形成した層46を転写した基板47に駆動 手段を接続し、封止処理を施して有機ELディスプレイ

【0011】このレーザ照射による転写法を用いたパタ ーン形成方法は、乾式であるため有機エレクトロルミネ ッセンス素子を構成する有機材料に有機溶剤や水等でダ 30 メージを与えることなく、且つ高精細なパターンを形成 することが可能になる。

[0012]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従 来の技術では、以下のような問題点があった。

【0013】従来の転写法を用いたパターン形成方法 は、多重に形成した層の転写を行う場合、各層の融点の 違いや積層順序により良好な転写が行えない場合があっ た。また良好な転写が行える場合でも、転写時の温度上 昇が大きいと転写層が熱によるダメージを受け劣化する 40 という問題点があった。

【0014】本発明は、上記のような課題を解決するた めになされたものであって、転写用フィルムおよびそれ を用いた有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法 に関する上記課題を解決し、転写を良好に行うことが可 能な転写用フィルムの提供と、それを用いた有機エレク トロルミネッセンス素子の製造方法を提供することを目 的とする。

[0015]

【課題を解決するための手段】本発明の転写用フィルム 50 【0023】また本発明の有機エレクトロルミネッセン

は、ベースフィルム上に転写層を有する転写用フィルム において、ベースフィルムと転写層との間に少なくとも 転写層に接して形成され転写層よりも融点またはガラス 転移温度が低い転写補助層を有し、転写補助層及び転写 層の少なくとも一部が加熱により他の基板上に転写形成 されることを特徴とする。本発明により、転写補助層が 無い場合に比べて低い温度で転写を行うことができるの で、転写層へ熱によるダメージを与えない温度での転写 が可能となる。

【0016】また本発明の転写用フィルムは、転写層に は少なくとも有機発光材料を含有するエレクトロルミネ ッセンス層が含まれていることを特徴とする。本発明に より、通常熱による影響を受け易い有機エレクトロルミ ネッセンス材料を転写層に用いた場合でも、熱によるダ メージを受けない有機エレクトロルミネッセンス層の転 写が可能となる。

【0017】また本発明の転写用フィルムは、転写層に は金属電極層が含まれていることを特徴とする。本発明 により、金属電極層も同時に転写することができるの で、金属電極層を含む複数の層を一度に転写することが 可能になる。

【0018】また本発明の転写用フィルムは、金属電極 層は光を透過する金属薄膜層であることを特徴とする。 本発明により、基板とは反対側からも光を取り出す、い わゆる逆取りだし構造の有機エレクトロルミネッセンス 素子の作成が可能になる。

【0019】また本発明の転写用フィルムは、転写層に は透明導電膜層が含まれていることを特徴とする。本発 明により、基板とは反対側から光を取り出す、いわゆる 逆積層構造の有機エレクトロルミネッセンス素子の作成 が可能になる。

【0020】また本発明の転写用フィルムは、転写補助 層および転写層は不活性ガス中または真空中で連続して 形成されることを特徴とする。本発明により、転写用フ ィルムの作製中に大気さらされることがないので、各層 の界面での劣化を押さえることが可能になる。

【0021】また本発明の有機エレクトロルミネッセン ス素子の製造方法は、上記に記載した機能を有する転写 用フィルムを用いることを特徴とする。本発明により、 熱によるダメージを与えない温度で種々の形態での有機 層の転写ができるので、様々な利用形態に応じた有機工 レクトロルミネッセンス素子の製造が可能になる。

【0022】また本発明の有機エレクトロルミネッセン ス素子の製造方法は、転写法は転写補助層への加熱を部 分的に行うことによりパターニングされた発光部を形成 することを特徴とする。本発明により、全面が発光する だけではなく任意のパターンでの発光ができるので、マ トリクス駆動が可能な有機エレクトロルミネッセンス素 子の製造が可能になる。

ス素子の製造方法は、パターニングされた発光部は複数 の発光色を有することを特徴とする。本発明により、容 易に高性能なマルチカラー表示、フルカラー表示の有機 エレクトロルミネッセンス素子の製造が可能になる。

【0024】また本発明の有機エレクトロルミネッセン ス素子の製造方法は、光一熱変換層を有する転写用フィ ルムを用い、光照射により転写補助層への加熱を部分的 に行うことを特徴とする。本発明により、例えばフォト マスク等を用いることにより、大面積基板への一括転写 が可能になる。

【0025】また本発明の有機エレクトロルミネッセン ス素子の製造方法は、光照射に用いる光源がレーザ光で あることを特徴とする。本発明により、レーザ光はその スポットを小さく絞り込むことができるので、より高精 細なパターニングが可能になる。

[0026]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態の転写 用フィルムおよびそれを用いた有機エレクトロルミネッ センス素子の製造方法について詳しく説明する。

【0027】転写用フィルムは、ベースフィルム上に転 20 写法により転写される転写層が形成されたものであり、 ベースフィルムと転写層との間に、少なくとも転写層に 接して転写補助層が形成されている。

【0028】ペースフィルムとしては、透明でフレキシ ブルな材料が好ましく、レーザ照射による転写を行う場 合は転写に用いるレーザ光の透過率が高い材料が特に好 ましい。また、フレキシブル性の高い材料であれば、凹 凸のある基板に転写用フィルムを隙間なく張り付けるこ ·とができる。このような材料としては、例えばポリエチ レンテレフタレート (PET), ポリカーボネート (P 30 C), ポリメチルメタクリレート (PMMA), ポリエ ステル, ポリアクリル, ポリエポキシ, ポリエチレン, ポリスチレン、ポリエーテルスルフォン等の高分子材料 があげられるがこれらに限定されるものではないが、ポ リエチレンテレフタレート、ポリカーボネートが最も好 ましい。また、膜厚としては、 $10\sim600\mu$ mが好ま しく、更に、 $50~200\mu$ mが好ましい。

【0029】転写補助層は、転写層よりも融点が低い材 料により形成され、加熱により溶融して転写層を基板上 ェニルアミン、トリフェニレン、パラターフェニル等の 芳香族系化合物、ステアリン酸、ベヘン酸等の飽和脂肪 酸系化合物や髙分子系材料等が挙げられる。転写層より 融点またはガラス転移温度が低くいものであればこれら に限定されるものではなく公知の材料が使用できるが、 ステアリン酸が最も好ましい。

【0030】転写補助層を用いて転写を行った場合、転 写補助層の一部あるいは全てが転写層と共に転写される 場合もあり、このような場合には、転写補助層には導電 性を持つ材料を用いることが好ましいが、絶縁性材料を 50 ッセンス素子用の公知の発光材料を用いることができ

用いなければならない場合は、出来るだけ層厚が薄い方 が有機エレクトロルミネッセンス素子の駆動電圧上昇を 避けることができるため好ましい。

【0031】転写層は、実際に転写工程により転写され る層であり、本発明の方法で用いられる転写層を構成す る層構造としては、例えば通常の有機エレクトロルミネ ッセンス素子を構成する有機層のみの構造でも、電極層 と有機層を組合せた構造で良く、例えば下記の構成が挙 げられるが本発明はこれらに限定されるものではない。

- (1)有機層
 - (2) 第1電極/有機層
 - (3) 有機層/第2電極
 - (4) 第1電極/有機層/第2電極

なお、転写層の構成としては、ベースフィルムに対して 順逆はどちらでも良い。

【0032】上記有機層は、単層構造でも多層構造でも 良く、例えば下記の構成が挙げられるが本発明はこれら に限定されるものではない。

- (1) 有機発光層
- (2) 正孔輸送層
- (3)電子輸送層
- (4) 正孔注入層
- (5) 正孔輸送層/有機発光層
- (6) 正孔注入層/正孔輸送層
- (7) 有機発光層/電子輸送層
- (8) 正孔輸送層/有機発光層/電子輸送層
- (9) 正孔注入層/正孔輸送層/有機発光層/電子輸送 層
- (10) 正孔注入層/正孔輸送層/有機発光層/ブロキ ング層/電子輸送層

上記有機発光層は、1層であっても良いし、多層構造で あっても良い。

【0033】有機発光層は、公知の方法で成膜すること が可能であり、例えば有機発光材料を直接真空蒸着法、 EB法、MBE法、スパッタ法等のドライプロセスで成 膜することが可能である。また、例えば有機発光層形成 用塗液を用いて、スピンコート法、ディップコート法、 ドクターブレード法、吐出コート法、スプレーコート 法、インクジェット法、凸版印刷法、凹版印刷法、スク に転写する働きを有する。このような材料としは、ジフ 40 リーン印刷法,マイクログラビアコート法等のウエット プロセスで成膜することも可能である。

> 【0034】上記有機発光層形成用塗液は、少なくとも 発光材料を含有した溶液であり、1種類もしくは多種類 の発光材料を含有していても良い。また、結着用樹脂が 含有していても良い。また、その他に、レベリング剤、 発光アシスト剤、電荷輸送材料、添加剤(ドナー、アク セプター等)、または発光性のドーパント等が含有され ていても良い。

> 【0035】発光材料としては、有機エレクトロルミネ

る。このような発光材料は、低分子発光材料、高分子発 光材料および高分子発光材料の前駆体等に分類される。 以下にこれらの具体的な化合物を例示するが、この発明 はこれらにより限定されるものではない。

【0036】低分子発光材料としては、例えば4,4' -ビス(2, 2'-ジフェニルビニル)-ビフェニル (DPVBi) 等の芳香族ジメチリデェン化合物、5-メチル-2-[2-[4-(5-メチル-2-ペンゾオ キサゾリル)フェニル] ビニル] ベンゾオキサゾール等 のオキサジアゾール化合物、3-(4-ピフェニルイ (1) -4-7ェニル -5-t-7 チルフェニル -12. 4-トリアゾール(TAZ)等のトリアゾール誘導 体、1,4-ビス(2-メチルスチリル)ベンゼン等の スチリルベンゼン化合物、チオピラジンジオキシド誘導 体、ベンゾキノン誘導体、ナフトキノン誘導体、アント ラキノン誘導体、ジフェノキノン誘導体、フルオレノン 誘導体等の蛍光性有機材料、アゾメチン亜鉛錯体、(8) -ヒドロキシキノリナト) アルミニウム錯体(A1 q,) 等の蛍光性有機金属化合物等が挙げられる。

【0037】一方、高分子発光材料としては、例えばポ 20 半導体材料、ポルフィリン化合物、N,N'-ビス-リ(2-デシルオキシ-1,4-フェニレン)DO-P PP、ポリ[2, 5-ビス-[2-(N, N, N-トリ エチルアンモニウム) エトキシ] -1, 4-フェニルー アルト-1, 4-フェニルレン] ジプロマイド (PPP -NE t¹)、ポリ [2-(2'-エチルヘキシルオキ シ) -5-メトキシ-1、4-フェニレンピニレン (MEH-PPV)、ポリ [5-メトキシー(2-プロ パノキシサルフォニド) -1, 4-フェニレンピニレ ン] (MPS-PPV)、ポリ[2, 5-ピスー(ヘキ シルオキシ)-1,4-フェニレン-(1-シアノピニ 30 ール(PVCz)等の高分子材料:ポリ(p-フェニレ レン)] (CN-PPV)、(ポリ(9,9-ジオクチ ルフルオレン)) (PDAF) 等が挙げられる。

【0038】また、高分子発光材料の前駆体としては、 例えばポリ (p-フェニレンビニレン) 前駆体 (Pre -PPV)、ポリ(p-ナフタレンピニレン)前駆体 (Pre-PNV)、ポリー(p-フェニレン)前駆体 (Pre-PPP) 等が挙げられる。

【0039】また、結着用樹脂としては、例えば、ポリ カーボネート、ポリエステル等が挙げられるが本発明は 特にこれらに限定されるわけでは無い。

【0040】また、溶剤としては、上記発光材料を溶解 または分散できる溶剤であれば良く、例えば、純水、メ タノール, エタノール, THF (テトラヒドロフラ ン), クロロホルム, トルエン, キシレン, トリメチル ベンゼン等が挙げられる。

【0041】正孔輸送層および電子輸送層は、それぞれ 単層構造でも多層構造でも良い。以下の説明において は、正孔と電子を合わせて「電荷」とも言う。

【0042】電荷輸送層は、公知の方法で成膜すること が可能であり、例えば電荷輸送材料を直接、真空蒸着

法、EB法、MBE法、スパッタ法等のドライプロセス で成膜することが可能である。また、例えば電荷輸送層 形成用塗液を用いて、スピンコート法、ディップコート 法、ドクタープレード法、吐出コート法、スプレーコー ト法、インクジェット法、凸版印刷法、凹版印刷法、ス クリーン印刷法、マイクログラピアコート法等のウエッ トプロセスで成膜することが可能である。また、電荷輸 送層形成用塗液は、少なくとも電荷輸送材料を含有した 溶液であり、1種類もしくは多種類の電荷輸送材料を含 10 有していても良い、また、結着用樹脂が含有していても 良い。また、その他に、レベリング剤、添加剤(ドナ ー、アクセプター等)等が含有されていても良く、本発 明は特にこれらに限定されるものではない。

【0043】電荷輸送材料としては、有機エレクトロル ミネッセンス素子用、有機光導電体用の公知の電荷輸送 材料が使用可能である。以下にこれらの具体的な化合物 を例示するが、この発明はこれらにより限定されるもの ではない。

【0044】正孔輸送材料としては、例えば、無機p型 (3-メチルフェニル) - N, N' - ピス - (フェニ ル) - ベンジジン (TPD)、N, N' - ジ (ナフタレ ン - 1 - イル) - N, N' - ジフェニル - ペンジジン (NPD) 等の芳香族第三級アミン化合物、ヒドラゾン 化合物、キナクリドン化合物、スチリルアミン化合物等 の低分子材料;ポリアニリン(PANI)、3、4-ボ リエチレンジオキシチオフェン/ポリスチレンサルフォ ネイト(PEDT/PSS)、ポリ(トリフェニルアミ ン誘導体)(Poly-TPD)、ポリビニルカルバゾ ンピニレン)前駆体(Pre-PPV)、ポリ(p-ナ フタレンピニレン) 前駆体 (Pre-PNV) 等の高分 子材料前駆体等等が挙げられる。

【0045】電子輸送材料としては、例えば、無機n型 半導体材料、オキサジアゾール誘導体、トリアゾール誘 導体、チオピラジンジオキシド誘導体、ベンゾキノン誘 導体、ナフトキノン誘導体、アントラキノン誘導体、ジ フェノキノン誘導体、フルオレノン誘導体などの低分子 材料;ポリ[オキサジアゾール [(Poly-OXZ) 40 等の高分子材料等が挙げられる。

【0046】また、結着用樹脂としては、例えば、ポリ カーボネート、ポリエステル等が挙げられるが、この発 明はこれらにより限定されるものではない。

【0047】また、溶剤としては、上記電荷輸送材料を 溶解または分散できる溶剤であれば特に限定されるもの ではなく、例えば、純水、メタノール、エタノール、T HF, クロロホルム, キシレン, トリメチルベンゼン等 が挙げられる。

【0048】プロッキング層は、単層構造でも多層構造 50 でも良い。また、プロッキング層形成用塗液は、少なく

とも電荷プロッキング材料を含有した溶液であり、1種 類もしくは多種類の電荷ブロッキング材料を含有してい ても良い。また、結着用樹脂が含有していても良い。ま た、その他に、レベリング剤等が含有されていても良 く、この発明はこれらにより限定されるものではない。 【0049】電荷ブロッキング材料としては、有機エレ クトロルミネッセンス素子用の公知の電荷ブロッキング 材料が使用可能である。例えば、電荷ブロッキング材料 としては、4、7-ジフェニル-1、10-フェナント ロリン、2、9-ジメチル-1、10-フェナントロリ 10 ン等が挙げられるが、この発明はこれらにより限定され るものではない。

【0050】また、結着用樹脂としては、例えば、ポリ カーボネート、ポリエステル等が挙げられるが、この発 明はこれらにより限定されるものではない。

【0051】また、溶剤としては、上記電荷プロッキン グ材料を溶解、または、分散できる溶剤であれば良く、 例えば、純水、メタノール、エタノール、THF、クロ ロホルム、キシレン、トリメチルベンゼン等が挙げられ る。

【0052】電極材料は、公知の電極材料を用いる事が 可能であり、陽極としては、仕事関数が高い金属(A u、Pt、Ni等)もしくは透明電極(ITO、IDI XO、SnO2等)を用いることができ、陰極としては 仕事関数の低い金属を少なくとも含有するもの(Ca、 Ce、Cs、Rb、Ba、Al、Mg:Ag合金、L i:A1合金)もしくは薄膜の絶縁層と金属電極を組み 合わせたもの(LiF/Al等)を用いることができ る。また、これらの材料は、EB、スパッタ、抵抗加熱 れらにより限定されるものではない。

【0053】次に、本発明の実施の形態による転写用フ ィルムを用いた有機エレクトロルミネッセンス素子の製 造方法について説明するが、これによりこの発明が限定 されるものではない。

【0054】図1(a)および(b)は本発明の実施の 形態での転写用フィルムおよびそれを用いた有機エレク トロルミネッセンス素子の製造方法を示す模式断面図で ある。尚、図1(b)は(a)とは直交する方向から見 た場合の模式断面図である。

【0055】図1(a)および(b)に示すように、転 写層1が形成された転写用フィルム2と第1電板3が形 成された基板4とを、転写層1と第1電極3とが内側に なるように張り付け、ベースフィルム2a側(転写用フ ィルム2のベースフィルム2a側)から熱Aを放射す る。ベースフィルム2aと転写層1との間には、少なく とも転写層1に接して形成され転写層1よりも融点が低 い転写補助層5があり、加熱された転写補助層5部分が 溶融し、転写層1の少なくとも一部が基板4上に転写形

とで有機エレクトロルミネッセンス素子を作製する。一 連の転写工程は、形成層(膜)の吸湿や材料の変質を考 慮して不活性ガス中で行うことが望ましい。また、第1 電極3, 第2電極のどちらか一方あるいは両方を転写法 により形成しても良い。

【0056】転写層は、単層構造、多層構造のいずれで あってもよい。転写層が有機エレクトロルミネッセンス 素子の構成層をすべて含む多層構造である場合には、転 写工程は1回で完了するが、転写層が有機エレクトロル ミネッセンス素子の構成層の一部を含む単層または多層 構造である場合には、上記転写工程を繰り返し行う必要 がある。

【0057】また、本発明の実施の形態の転写用フィル ムを用いた転写法と、公知のドライプロセスおよび/ま たはウエットプロセスとを組み合わせて、有機エレクト ロルミネッセンス素子を製造しても良い。公知のドライ プロセスとしては、真空蒸着法、EB法、MBE法、ス パッタ法等が挙げられ、公知のウェットプロセスとして は、スピンコート法、ディップコート法、ドクタープレ 20 ード法、吐出コート法、スプレーコート法等の塗布法 や、インクジェット法、凸版印刷法、凹版印刷法、スク リーン印刷法、マイクログラビアコート法等の印刷法が 挙げられる。

【0058】図2(a)および(b)は本発明の他の実 施の形態での転写用フィルムおよびそれを用いた有機工 レクトロルミネッセンス素子の製造方法を示す模式断面 図である。尚、図2(b)は(a)とは直交する方向か ら見た場合の模式断面図である。

【0059】図2(a) および(b) に示すように、転 蒸着法等で形成することが可能であるが、この発明はこ 30 写層21が形成された転写用フィルム22と第1電極2 3が形成された基板24とを、転写層21と第1電極2 3とが内側になるように張り付け、ベースフィルム22 a側(転写用フィルム22のベースフィルム22a側) からレーザ光Bを照射する。ベースフィルム22aと転 写層21との間には、少なくとも転写層21に接して形 成され転写層21よりも融点が低い転写補助層25と光 - 熱変換層26とがあり、レーザ光Bは光-熱変換層2 6により熱に変換され、これにより加熱された転写補助 層25部分が溶融し、転写層21の少なくとも一部が基 40 板24上に転写形成される。その後、必要に応じて第2 電極27を形成することで有機エレクトロルミネッセン ス素子を作製する。一連の転写工程は、形成層(膜)の 吸湿や材料の変質を考慮して不活性ガス中で行うことが 望ましい。また、第1電極23,第2電極27のどちら か一方あるいは両方を転写法により形成しても良い。 尚、本実施形態では、第2電極27を他の転写層21と 同時に形成した場合の例を示している。

【0060】転写層は、単層構造、多層構造のいずれで あってもよい。転写層が有機エレクトロルミネッセンス 成される。その後、必要に応じて第2電極を形成するこ 50 案子の構成層をすべて含む多層構造である場合には、転 11

写工程は1回で完了するが、転写層が有機エレクトロルミネッセンス素子の構成層の一部を含む単層または多層構造である場合には、上記転写工程を繰り返し行う必要がある。

【0061】また、本実施形態の転写用フィルムを用いた転写法と、公知のドライプロセスおよび/またはウエットプロセスとを組み合わせて、有機エレクトロルミネッセンス素子を製造しても良い。公知のドライプロセスとしては、真空蒸着法、EB法、MBE法、スパッタ法等が挙げられ、公知のウェットプロセスとしては、スピ 10ンコート法、ディップコート法、ドクターブレード法、吐出コート法、スプレーコート法等の塗布法や、インクジェット法、凸版印刷法、凹版印刷法、スクリーン印刷法、マイクログラビアコート法等の印刷法が挙げられる。

【0062】図3は本発明の実施の形態を用いて作成された有機エレクトロルミネッセンス素子の一例を示す模式上面図である。

【0063】図3に示すように、有機赤色発光多層膜31a(例えば、正孔輸送層/赤色発光層からなる。)、有機緑色発光多層膜31b(例えば、正孔輸送層/緑色発光層からなる。)、有機青色発光多層膜31c(例えば、正孔輸送層/青色発光層からなる。)をそれぞれベースフィルム上に形成した転写用フィルムを用い、転写の工程を繰り返すことで基板34上に赤色、緑色、青色発光多層膜からなる多色発光の有機エレクトロルミネッセンス素子を形成する。基板34上には、薄膜トランジスタ等のスイッチング素子38が画素毎に形成されている。

[0064]

【実施例】次に、具体的な実施例により本発明をさらに 詳細に説明するが、本発明はこれらの例によってなんら 限定されるものではない。

【0065】 (実施例1) ベースフィルムとして厚さ1 50μmのポリエチレンテレフタレートを用い転写補助 層としてはステアリン酸を蒸着で100nmの厚さで形 成した。ステアリン酸の融点は68℃である。さらに転 写層として有機発光層である(8-ヒドロキシキノリナ ト) アルミニウム錯体 (Alg₃) (融点:413℃、 ガラス転移温度:175℃)、正孔輸送材料であるN. N'-ジ(ナフタレン-1-イル)-N, N'-ジフェ ニル - ベンジジン (NPD) (融点:275℃、ガラス 転移温度:95℃) をそれぞれ50nmの厚さで蒸着に より形成した。このようにして作製した転写用フィルム を、あらかじめパターニングをした透明電極付きガラス 基板と貼り合わせ、ベースフィルム側からライン状の熱 源(たとえば電気を流した二クロム線)を押し当て、転 写補助層を溶かすことにより転写層が透明電極付きガラ ス基板上に転写した。またステアリン酸の融点がNP D、Alq、のガラス転移温度より低いため転写時の熱 による転写層の劣化もなく、転写後に転写層上に陰極を 形成することによりAlq,からの緑色発光が確認でき た。これに赤色、青色の発光を示す有機発光層を形成し た転写用フィルムを用いて転写を三度行えば、R、G、 Bのフルカラー発光が可能な有機エレクトロルミネッセ ンス素子の作成が可能となる。

【0066】(実施例2)転写層としてA1層/A1q,層/NPD層の多層膜,光を透過する金属薄膜A1層/A1q,層/NPD層の多層膜,透明導電膜層/NPD層の多層膜,透明導電膜層/NPD層/A1q,層の多層膜のいずれかを使用した以外は実施例1と同様である。この場合も良好な転写が行われた。電極層も同時に転写することにより、プロセスの工程数削減が可能となる。一般に電極層として用いる材料は無機物であるため有機物と比較して硬度が大きいため良好な転写を行うためには膜厚は薄い方が好ましい。また、金属薄膜A1層/A1q,層/NPD層の多層膜,または透明導電膜層/NPD層/A1q,層の構造にすると、発光を基板と反対側から取り出すことが可能になるため、特にTFTなどのスイッチング素子を用いたアクティブ駆動を行う場合には開口率の減少を避けることができる。

【0067】 (実施例3) ベースフィルムとして厚さ1 50μmのポリエチレンテレフタレートを用い、光-熱 変換層としてカーボンブラックを高分子材料に分散した 層を形成した。転写補助層、正孔輸送層、発光層は実施 例1と同様である。このようにして作製した転写用フィ ルムを、あらかじめパターニングをした透明電極付きガ ラス基板と貼り合わせ、ベースフィルム側からレーザ光 を照射し光 - 熱変換層での発熱を利用して転写補助層を 溶かすことにより、転写層を透明電極付きガラス基板上 に転写した。レーザ光のパワーを適当に選ぶことにより 良好な転写層が得られ、さらに転写層上に陰極層を形成 することによりAlg,からの緑色発光が確認できた。 レーザ光はレンズ等の光学系により細く絞ることが可能 であり、転写幅の細い転写層の作製が容易なため有機工 レクトロルミネッセンス素子の高精細化ができる。光 -熱変換層は例えば、アルミニウム、その酸化物/硫化物 からなる金属膜、黒鉛、赤外線染料などを高分子材料に 分散したものを用いることが可能である。

40 【0068】(実施例4)転写補助層及び転写層を真空中で連続して形成した以外は実施例1と同様である。真空中で連続して各層を形成することにより、大気による各層の界面での劣化が押さえられ有機エレクトロルミネッセンス素子の特性が向上する。

【0069】上記各々の実施例では有機発光層,正孔輸送層等に低分子化合物を用いた場合について述べたが、高分子材料を用いた場合も同様である。高分子材料の場合は塗布法による形成であるため窒素雰囲気中で行うことが好ましい。

50 [0070]

13

【発明の効果】以上説明したように、本発明の転写用フィルムは、ベースフィルム上に転写層を有する転写用フィルムにおいて、ベースフィルムと転写層との間に少なくとも転写層に接して形成され転写層よりも融点またはガラス転移温度が低い転写補助層を有し、転写補助層及び転写層の少なくとも一部が加熱により他の基板上に転写形成されることを特徴とし、本発明により、転写補助層が無い場合に比べて低い温度で転写を行うことができるので、転写層へ熱によるダメージを与えない温度での転写が可能になるので、転写層が持っている本来の機能 10を損なうことなく良好な転写が行える転写用フィルムが提供できる。

【0071】また本発明の転写用フィルムは、転写層には少なくとも有機発光材料を含有するエレクトロルミネッセンス層が含まれていることを特徴とし、本発明により、通常熱による影響を受け易い有機エレクトロルミネッセンス材料を転写層に用いた場合でも、熱によるダメージを受けない有機エレクトロルミネッセンス層の転写がが可能になるので、発光特性が良好な有機エレクトロルミネッセンス層の転写が行える転写用フィルムが提供20できる。

【0072】また本発明の転写用フィルムは、転写層には金属電極層が含まれていることを特徴とし、本発明により、金属電極層も同時に転写することができるので、金属電極層を含む複数の層を一度に転写することが可能になるので、有機エレクトロルミネッセンス素子の作製時の転写用フィルム数を減らすことができるので、製造時の工数の低減とコストダウンが達成できる。

【0073】また本発明の転写用フィルムは、金属電極層は光を透過する金属薄膜層であることを特徴とし、本 30 発明により、基板とは反対側からも光を取り出す、いわゆる逆取りだし構造の有機エレクトロルミネッセンス素子の作成が可能になるので、例えばTFT付基板を用いた場合の1画素単位の開口率を大きくすることができる。また、有機エレクトロルミネッセンス素子の両面からの光取り出しも可能となり、例えば両面表示パネルへの適用等、有機エレクトロルミネッセンス素子の使用用途が広がる。

【0074】また本発明の転写用フィルムは、転写層には透明導電膜層が含まれていることを特徴とし、本発明 40により、基板とは反対側から光を取り出す、いわゆる逆積層構造の有機エレクトロルミネッセンス素子の作成が可能になるので、例えばTFT付基板を用いた場合の1画素単位の開口率を大きくすることができる。

行える転写用フィルムが提供できる。

【0076】また本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法は、上記に記載した機能を有する転写用フィルムを用いることを特徴とし、本発明により、熱によるダメージを与えない温度で種々の形態での有機層の転写ができるので、様々な利用形態に応じた有機エレクトロルミネッセンス素子の製造が可能になるので、発光特性が良好な他種類の有機エレクトロルミネッセンス素子が提供できる。

【0077】また本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法は、転写法は転写補助層への加熱を部分的に行うことによりパターニングされた発光部を形成することを特徴とし、本発明により、全面が発光するだけではなく任意のパターンでの発光ができるので、マトリクス駆動が可能な有機エレクトロルミネッセンス素子の製造が可能になるので、キャラクター表示、グラフィック表示、画像表示等が可能な有機エレクトロルミネッセンス素子が提供できる。

【0078】また本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法は、パターニングされた発光部は複数の発光色を有することを特徴とし、本発明により、容易に高性能なマルチカラー表示、フルカラー表示の有機エレクトロルミネッセンス素子の製造が可能になるので、カラー表示による表示情報量の多い有機エレクトロルミネッセンス素子が提供できる。

【0079】また本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法は、光一熱変換層を有する転写用フィルムを用い、光照射により転写補助層への加熱を部分的に行うことを特徴とし、本発明により、例えばフォトマスク等を用いることにより、大面積基板への一括転写が可能になるので、製造コストを下げることができ安価な有機エレクトロルミネッセンス素子が提供できる。

【0080】また本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法は、光照射に用いる光源がレーザ光であることを特徴とし、本発明により、レーザ光はそのスポットを小さく絞り込むことができるので、より高精細なパターニングが可能になるので、携帯端末等の表示部に利用可能な高精細の有機エレクトロルミネッセンス素子が提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】(a) および(b) は本発明の実施の形態での 転写用フィルムおよびそれを用いた有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法を示す模式断面図である。。 【図2】(a) および(b) は本発明の他の実施の形態 での転写用フィルムおよびそれを用いた有機エレクトロ

での転写用フィルムおよびそれを用いた有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法を示す模式断面図である。

【図3】本発明の実施の形態を用いて作成された有機エレクトロルミネッセンス素子の一例を示す模式上面図である。

16

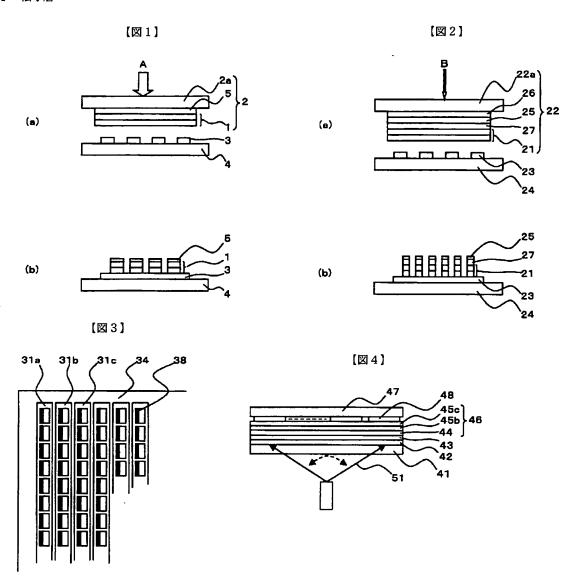
15

【図4】従来の転写用フィルムおよびそれを用いた有機 エレクトロルミネッセンス素子の製造方法を示す模式断 面図である。

【符号の説明】

1 転写層

- 2 転写用フィルム
- 2 a ベースフィルム
- 4 基板
- 5 転写補助層



フロントページの続き

(72)発明者 赤井 伴教

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内

F ターム(参考) 3B005 EA20 EB01 EC30 FA02 FB12 3K007 AB04 AB18 BA06 CA06 CB01 CB03 DA01 DB03 EB00 FA01